

XT3516

GaAs 次谐波混频器
24~34GHz

Rev 1.1

关键指标

- RF 频段: 24~34GHz
- LO 频段: 12~18GHz
- IF 频段: DC~4GHz
- 变频损耗: 9dB
- 本振功率: 4dBm
- 芯片尺寸: 1.78mm × 1.13mm × 0.1mm

典型应用

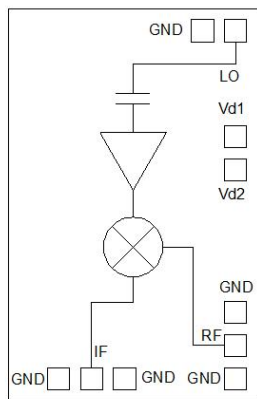
- 电子对抗
- 雷达
- 卫星通讯
- 测试测量

产品简介

XT3516 是一款频段为 24~34GHz 次谐波混频器。该芯片采用 GaAs 工艺中制造, 无须外部元件或匹配电路。该装置既可作为上变频器又可用于下变频器。

该芯片有全表面钝化保护提高可靠性。

功能框图



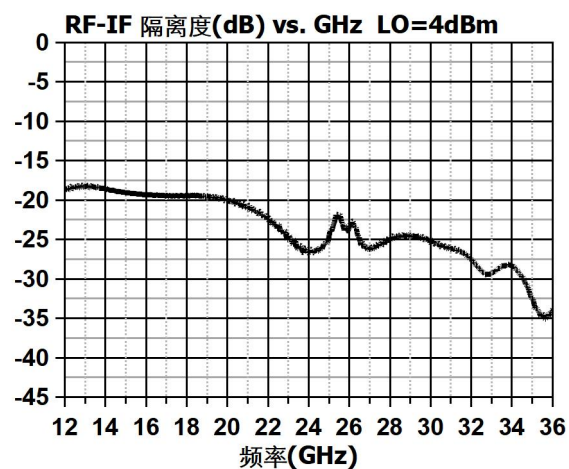
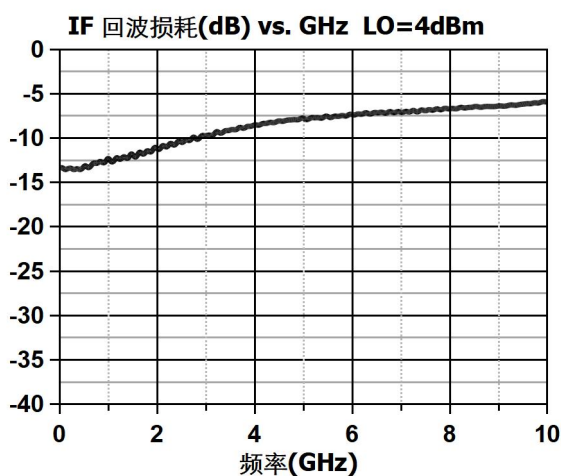
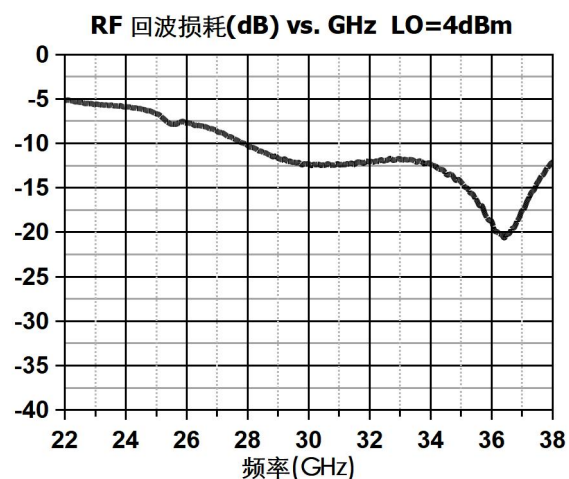
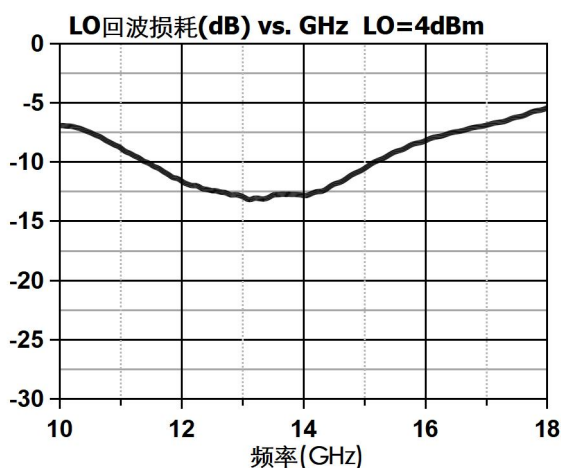
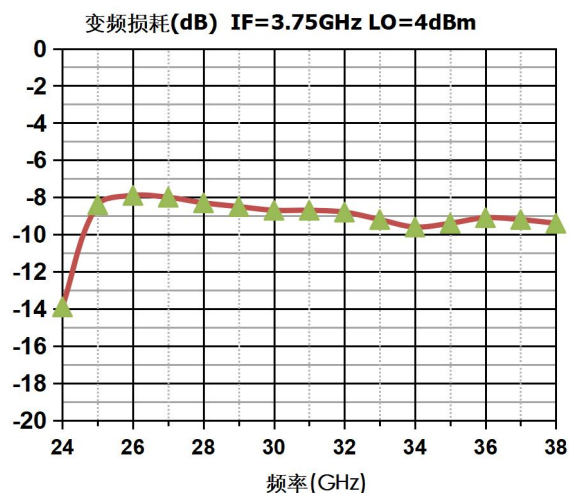
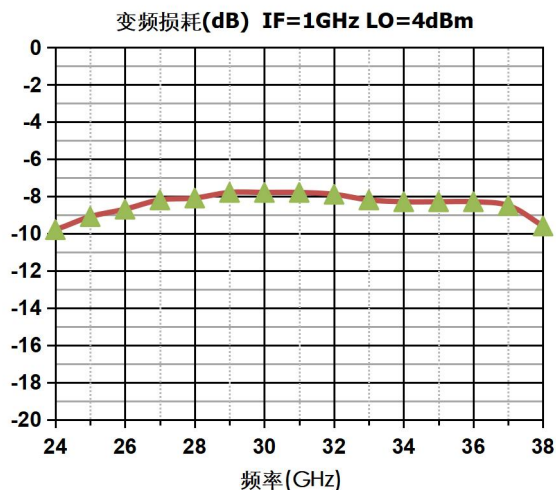
电性能 (T_A=25°C, LO=4dBm)

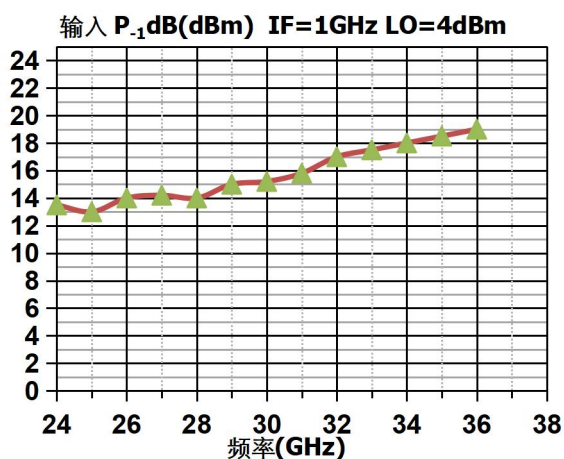
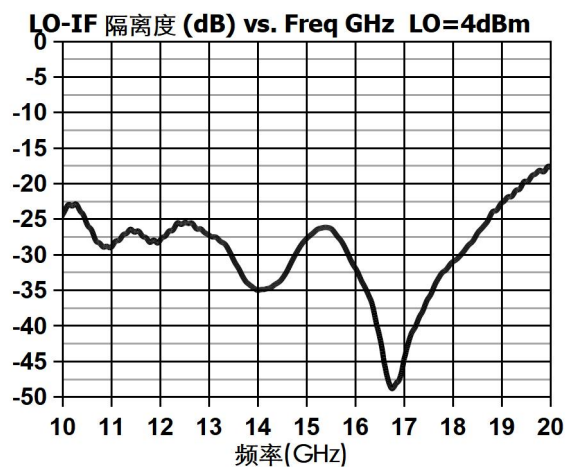
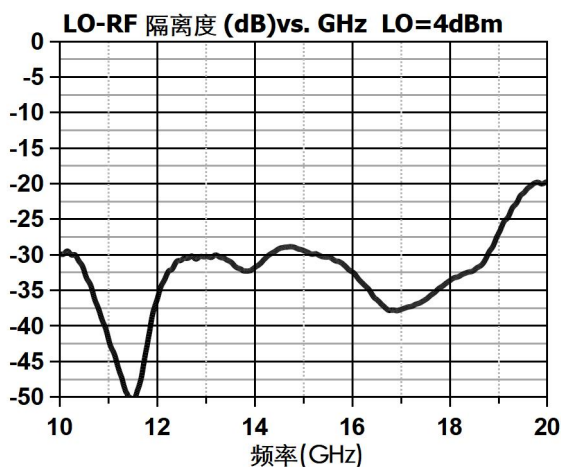
指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	24~34			GHz
本振频率	12~18			GHz
中频频率	DC~4			GHz
变频损耗		-9		dB
中频端回波损耗		-10		dB
射频端回波损耗		-10		dB
本振端回波损耗		-10		dB
本振-射频隔离度		-35		dB
本振-中频隔离度		-30		dB
射频-中频隔离度		-25		dB
供电电流		90		mA

绝对最大额定值

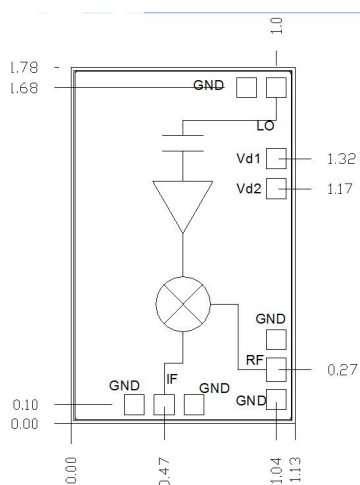
射频/中频最大输入功率	15dBm	工作温度	-55°C~+85°C
本振最大输入功率	15dBm	存储温度	-65°C~+150°C

典型测试曲线

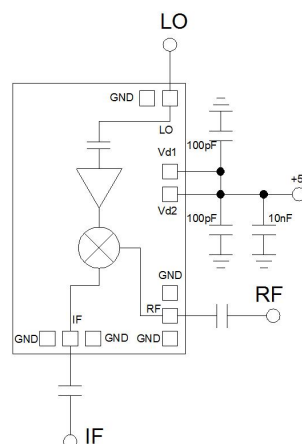




外形和端口尺寸 (以 mm 为单位)



推荐装配图



注意事项

砷化镓 MMIC 器件易受静电放电损伤。在运输、装配和试验过程中应采取防范措施。